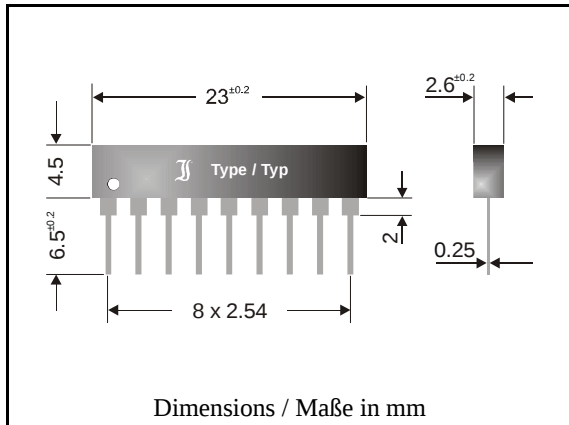


Rectifier Arrays

Gleichrichter Sätze

Version 2004-10-01



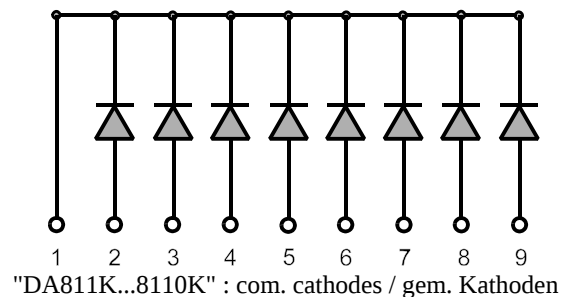
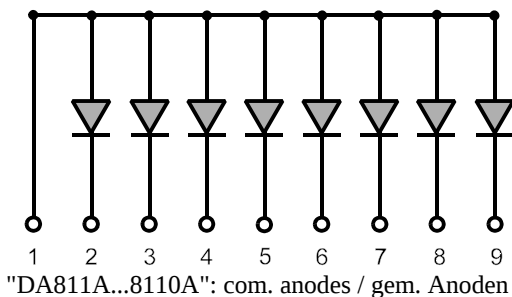
Nominal power dissipation 1.2 W
Nenn-Verlustleistung

Repetitive peak reverse voltage 100...1000 V
Periodische Spitzensperrspannung

9 Pin-Plastic case 23 x 2.6 x 4.5 [mm]
9 Pin-Kunststoffgehäuse

Weight approx. – Gewicht ca. 0.6 g

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton



Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DA811A/K	100	120
DA814A/K	400	480
DA8110A/K	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load,
for one diode operation only
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV} 600 mA ¹⁾
 I_{FAV} 150 mA ¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwertschaltung mit R-Last,
für eine einzelne Diode
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV} 600 mA ¹⁾
 I_{FAV} 150 mA ¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FSM} 30 A

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	$1.2 \text{ W}^1)$
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	$-50\dots+150^\circ\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	$-50\dots+150^\circ\text{C}$

Characteristics**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1 \text{ A}$	V_F	$< 1.1 \text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	I_R I_R	$< 10 \mu\text{A}$ $< 90 \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 85 \text{ K/W}^1)$

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten